








	<h2>SI3909DV-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3909DV-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2P-CH 20V 6TSOP</p> <p>Datenblätter:  SI3909DV-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 13030 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3909DV-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 20V 6TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	13030 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 20V 1.15W Surface
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1.15W
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	200 mOhm @ 1.8A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	500mV @ 250µA (Min)
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SI3909DV-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI3909DV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3909DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3909DV-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3911DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 1.8A 6TSOP</p>	 <p>SI3911DV-T1 VISHAY SI3911DV-T1 VISHAY</p>	 <p>SI3909DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 6TSOP</p>	 <p>SI3911DV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 1.8A 6TSOP</p>
 <p>SI3905DV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 8V 6-TSOP</p>	 <p>SI3909DV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 6TSOP</p>	 <p>SI3909DV-T1 SIL SI3909DV-T1 SIL</p>	 <p>SI3909DV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 6TSOP</p>

heiße Teile

Mehr

SI3865BDV-T1-E3	SI3865CDV-T1-GE3	SI3865CDV-T1-GE3	SI3865DV-T1	SI3865DV-T1-E3
SI3865DV-T1-GE3	SI3867DV-T1-E3	SI3867DV-T1-E3	SI3867DV-T1-GE3	SI3867DV-T1-GE3
SI3879DV-T1-E3	SI3879DV-T1-E3	SI3900DV	SI3900DV-T1-E3	SI3900DV-T1-E3
SI3900DV-T1-GE3	SI3900DV-T1-GE3	SI3905DV-T1	SI3905DV-T1-E3	SI3905DV-T1-E3
SI3905DV-T1-GE3	SI3905DV-T1-GE3	SI3909DV-T1	SI3909DV-T1-E3	SI3909DV-T1-E3
SI3909DV-T1-GE3	SI3911DV	SI3911DV-T1	SI3911DV-T1-E3	SI3911DV-T1-E3
SI3911DV-T1-G33	SI3911DV-T1-GE3	SI3911DV-T3-E3	SI3915DV	SI3915DV-T1-E3
SI3915DV-T1-GE3	SI3932DV-T1-GE3	SI3932DV-T1-GE3	SI3948DV-T1	SI3948DV-T1-E3
SI3948DV-T1-E3	SI3948DV-T1-GE3	SI3948DV-T1-GE3	SI3951-KU	SI3951DV-T1-E3
SI3951DV-T1-E3	SI3951DV-T1-GE3	SI3951DV-T1-GE3	SI3981DV-T1-E3	SI3981DV-T1-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited